

Содержание

Еремин В.К., Фадеева Н.Н., Вербицкая Е.М., Еремин И.В.

Физическое обоснование предела временного разрешения кремниевых планарных детекторов длиннопробежных тяжелых ионов 333

● **XXVIII Международный симпозиум „Нанофизика и наноэлектроника“, Нижний Новгород, 11–15 марта 2024 г.**

Кукушкин В.А., Кукушкин Ю.В.

Потенциальное быстроедействие алмазного полевого транзистора на приповерхностном двумерном дырочном газе 283

● **Электронные свойства полупроводников**

Давидович М.В.

К электродинамике полупроводниковых магнитоплазменных волноводов 288

● **Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**

Марков Л.К., Смирнова И.П., Павлюченко А.С., Яговкина М.А., Аксенова В.В.

Модификация структуры нанокристаллических пленок оксида индия и олова 297

Лебедев М.В., Львова Т.В., Седова И.В., Королева А.В., Жижин Е.В., Лебедев С.В.

Пассивация поверхностей AlGaAs(100) растворами сульфида аммония 302

● **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Харченко А.А., Надточий А.М., Шерняков Ю.М., Гордеев Н.Ю., Паюсов А.С., Бекман А.А., Корнышов Г.О., Симчук О.И., Салий Ю.А., Кулагина М.М., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Максимов М.В.

Оптическое усиление в волноводных гетероструктурах спектрального диапазона 1010–1075 нм с активной областью на основе InGaAs квантовых яма-точек 313

Бабичев А.В., Надточий А.М., Блохин С.А., Неведомский В.Н., Крыжановская Н.В., Бобров М.А., Васильев А.П., Малеев Н.А., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Егоров А.Ю.

Исследование структурных и оптических свойств InGaAs-квантовых точек 318

● **Физика полупроводниковых приборов**

Кардо-Сысоев А.Ф., Черенёв М.Н., Люблинский А.Г., Смирнова И.А., Юсупова Ш.А., Белякова Е.И., Векслер М.И.

Влияние внешних параметров на процесс переключения при задержанной ионизации в кремниевой $p^+ - n - n^+$ -структуре 326